

固体辐射物理研究室知识库

ALL 精确检索请加双引号 Go

- 首页
- 研究单元&专题
- 作者
- 文献类型
- 学科分类
- 知识图谱
- 新闻&公告

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

总剂量电离辐射后碳化硅垂直双扩散型晶体管开关响应异常变化的测试方法

余学峰⁺; 蒲晓娟; 冯皓楠; 魏莹; 冯婕; 李豫东⁺; 郭旗⁺

2022-07-15

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种用于总剂量电离辐射后碳化硅垂直双扩散型晶体管开关响应异常变化的测试方法,该方法设计装置是由静电试验平台、样品测试版、脉冲发生器、高压电源、示波器和计算机组成,在一定时间内一定温度条件下利用示波器上的高压探头准确快速地测量碳化硅垂直双扩散型晶体管开关响应时间,测量时需在晶体管的栅极与脉冲发生器连接;然后由脉冲发生器发出预先设定周期,脉冲宽度,高位电压,低位电压的信号,再依据MIL-STD-750/3472标准测量器件开关时间的参数,通过计算机对辐照前后测试得到的晶体管开关响应进行比对,生成辐照引起开关响应的退化差值,再设定合理的预值,如果退化差值大于预值则会根据实验积累的数据快速判断器件开关响应的异常情况。本发明操作方便快捷,具有一定的通用性。

申请日期 2022-04-19

申请号 CN202210408396.8

公开(公告)号 114755550A

代理机构 乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型 **专利**

条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8685>

专题 固体辐射物理研究室

推荐引用方式 余学峰,蒲晓娟,冯皓楠,等. 总剂量电离辐射后碳化硅垂直双扩散型晶体管开关响应异常变化的测试方法. 114755550A[P]. GB/T 7714 2022-07-15.

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

📖 谷歌学术中相似的文章

📖 [余学峰]的文章

📖 [蒲晓娟]的文章

📖 [冯皓楠]的文章

百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [余学峰]的文章

📖 [蒲晓娟]的文章

📖 [冯皓楠]的文章

必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [余学峰]的文章

📖 [蒲晓娟]的文章

📖 [冯皓楠]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享



反馈留言

